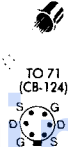


FET DUAL TRANSISTORS, N CHANNEL

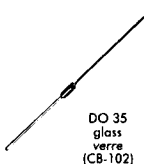
Types	Application	V _{(BR)GSS} min (V)	I _{GSS} max (nA) [*]	I _{DSS} min-max (mA)	Y _{21s} min-max (mS)	V _{GSoff} min-max (V)	C _{11ss} max (pF)	C _{12ss} max (pF)	Matching Appariement				Case
									Y _{21s} (%)	I _{DSS} (%)	V _{GS1} -V _{GS2} (mV)	ΔV _{GS} /ΔT (μV/°C)	
ESM 25 ESM 25 A 2N 5198 2N 5199	AF/RF general purpose Usage général BF/HF	-30	0,1	0,5-10	1-5	-0,7-4,5	6	2	20	20	25	80	 TO 71 (CB-124)
		-30	0,1	0,5-10	1-5	-0,7-4,5	6	2	20	20	25	50	
		-30	25 *	0,7- 7	1-0,7	-0,7-4	6	2	5	5	10	20	
		-30	25 *	0,7- 7	1-0,7	-0,7-4	6	2	5	5	10	40	

^{*} CNES qualified product.

SCHOTTKY SMALL SIGNAL DIODES

Types	V _{RRM} (V)	I _F I _O [*] (mA)	I _R (1) max (μA)	V _R (V)	V _F (1) max (V)	I _F (mA)	C max (pF)	V _R (V)	Dynamic parameters Paramètres dynamiques	Case
-------	-------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---	------

UHF and ultra fast switching T_{amb} = 25°C

N	BAR 19	4	30	0,25	3	0,6	10	1	1	F = 6 dB / 1 GHz Q _s < 3 pC / 10 mA T < 100 ps / 20 mA t _{rr} < 1 ns / 3 mA	 DO 35 glass verre (CB-102)
	BAT 29	5	30	0,05	1	0,55	10	1	0		
	BAT 19	10	30	0,1	5	0,4	1	1,2	0		
	BAT 45	15	30	0,1	6	0,5	10	1,1	1		
N	BAR 10	20	35	0,1	15	0,41	1	1,2	0	T < 100 ps / 5 mA T < 100 ps / 5 mA T < 100 ps / 5 mA	
	BAR 11	15	20	0,1	8	0,41	1	1,2	0		
	1N 5712	20	35	0,15	16	0,55	1	1,2	0		
	BAR 28	70	15	0,2	50	0,41	1	2	0		
N	1N 5711	70	15	0,2	50	0,41	1	2	0	T < 100 ps / 5 mA T < 100 ps / 5 mA	
	1N 6263	60	15	0,2	50	0,41	1	2,2	0		

F : Mixer noise figure.

Q_s : Stored charge (B-line).

T : Minority carrier life time (Kraukaver method).

(1) Pulse test I_p ≤ 300 μs δ < 2%.

N : New product.

7